

Symbol	Typ	Titel
G	Sektion	Sektion G – Physik
G11	Klasse	Informationsspeicherung
G11C	Unterklasse	Statische Speicher (Informationsspeicherung mit Relativbewegung zwischen Aufzeichnungsträger und Wandler G11B; Halbleiterbauelemente zur Speicherung H01L , z.B. H01L 27/108-H01L 27/115; Impulstechnik allgemein H03K , z.B. elektronische Schalter H03K 17/00)
G11C 5/00	Hauptgruppe	Einzelheiten von Speichern, soweit sie von G11C 11/00 umfasst sind
G11C 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Räumliche Anordnungen von Speicherelementen, z.B. in der Form einer Matrix
G11C 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . Halterungen für Speicherelemente; Anbringen oder Befestigen von Speicherelementen an diesen Halterungen
G11C 5/05	3-Punkt Untergruppe	. . . Halterung der Kerne in der Matrix [2]
G11C 5/06	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zur elektrischen Verbindung von Speicherelementen, z.B. durch Verdrahtung
G11C 5/08	2-Punkt Untergruppe	. . zur gegenseitigen Verbindung von magnetischen Elementen, z.B. von Ringkernen
G11C 5/10	2-Punkt Untergruppe	. . zur gegenseitigen Verbindung von Kondensatoren
G11C 5/12	1-Punkt Untergruppe	. Geräte oder Verfahren zur gegenseitigen Verbindung von Speicherelementen, z.B. zum Einfädeln von Magnetkernen
G11C 5/14	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zur Spannungsversorgung (Hilfsschaltungen für Halbleiterspeicher G11C 11/4063 , G11C 11/413 , G11C 11/4193; allgemein G05F , H02J , H02M) [5, 7]
G11C 7/00	Hauptgruppe	Anordnungen zum Einschreiben oder Auslesen von Informationen in einen bzw. aus einem digitalen Speicher (G11C 5/00 hat Vorrang; Hilfsschaltungen für Halbleiterspeicher G11C 11/4063 , G11C 11/413 , G11C 11/4193) [2, 5]
G11C 7/02	1-Punkt Untergruppe	. unter Vermeidung von Störsignalen
G11C 7/04	1-Punkt Untergruppe	. unter Vermeidung von Störungen durch Temperatureinflüsse
G11C 7/06	1-Punkt Untergruppe	. Leseverstärker; zugehörige Schaltungen (Verstärker <u>an sich</u> H03F , H03K) [1, 7]
G11C 7/08	2-Punkt Untergruppe	. . Steuerungen hierfür [7]
G11C 7/10	1-Punkt Untergruppe	. Eingabe/Ausgabe [I/O]-Datenschnittstellenanordnungen, z.B. I/O-Datensteuerungen, I/O-Datenpuffer (Pegelumsetzer allgemein H03K 19/0175) [7]
G11C 7/12	1-Punkt Untergruppe	. Bitleitungssteuerungen, z.B. Treiber, Verstärker, Pull-up-Schaltungen, Pull-down-Schaltungen, Voraufladungsschaltungen, Entzerrerschaltungen für Bitleitungen [7]
G11C 7/14	1-Punkt Untergruppe	. Dummyzellenverwaltung; Lesevergleichsspannungserzeuger [7]
G11C 7/16	1-Punkt Untergruppe	. Speichern von Analogsignalen in digitalen Speichern unter Verwendung von Anordnungen, die Analog/Digital [A/D]-Wandler, digitale Speicher und Digital/Analog [D/A]-Wandler umfassen [7]
G11C 7/18	1-Punkt Untergruppe	. Organisation der Bitleitungen; Layout der Bitleitungen [7]
G11C 7/20	1-Punkt Untergruppe	. Initialisierungsschaltungen für Speicherzellen, z.B. während des Ein- oder Ausschaltens, Löschen des Speichers, latenter Bildspeicher [7]
G11C 7/22	1-Punkt Untergruppe	. Lese-/Schreib [R/W]-Zeitsteuerungs- oder Taktschaltungen; Erzeugung oder Verwaltung von Lese-/Schreib [R/W]-Steuersignalen [7]
G11C 7/24	1-Punkt Untergruppe	. Sicherheits- oder Schutzschaltungen für Speicherzellen, z.B. Anordnungen zur Verhinderung unbeabsichtigten Lesens oder Schreibens; Statuszellen; Testzellen [7]

Symbol	Typ	Titel
G11C 8/00	Hauptgruppe	Anordnungen zur Adressenauswahl für einen digitalen Speicher (für Hilfsschaltungen für Halbleiterspeicher G11C 11/4063 , G11C 11/413 , G11C 11/4193) [2, 5]
G11C 8/02	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung einer Auswahlmatrix [2]
G11C 8/04	1-Punkt Untergruppe	. mit sequenziell adressierender Einrichtung, z.B. Schieberegister, Zähler (Verwendung von FIFO-Registern zur Veränderung der Geschwindigkeit des digitalen Datenflusses G06F 5/06; Verwendung von LIFO-Registern zur Verarbeitung digitaler Daten durch Eingriff in deren Reihenfolge G06F 7/00) [5]
G11C 8/06	1-Punkt Untergruppe	. Adressier-Schnittstellenanordnungen, z.B. Adressenpuffer (Pegelumwandlungsschaltungen allgemein H03K 19/0175) [7]
G11C 8/08	1-Punkt Untergruppe	. Steuerungsschaltungen für Wortleitungen, z.B. Treiber, Verstärker, Pull-up-Schaltungen, Pull-down-Schaltungen, Voraufladungsschaltungen für Wortleitungen [7]
G11C 8/10	1-Punkt Untergruppe	. Decoder [7]
G11C 8/12	1-Punkt Untergruppe	. Gruppenauswahlschaltungen, z.B. zur Speicherblockauswahl, Chipauswahl, Matrixauswahl [7]
G11C 8/14	1-Punkt Untergruppe	. Organisation der Wortleitungen; Layout der Wortleitungen [7]
G11C 8/16	1-Punkt Untergruppe	. Speichermatrix mit Mehrfachzugriff, z.B. Adressieren eines Speicherelements über mindestens zwei unabhängige Adressleitungsgruppen [7]
G11C 8/18	1-Punkt Untergruppe	. Adressen-Zeitsteuerungs- oder Taktschaltungen; Erzeugung oder Verwaltung von Adressensteuersignalen, z.B. für Zeilenadrestakt-Signale [RAS] oder Spaltenadrestakt-Signale [CAS] [7]
G11C 8/20	1-Punkt Untergruppe	. Sicherheits- oder Schutzschaltungen für Adressen, d.h. Anordnungen zur Verhinderung unberechtigter oder unbeabsichtigter Zugriffe [7]
G11C 11/00	Hauptgruppe	Digitale Speicher, gekennzeichnet durch die Verwendung besonderer elektrischer oder magnetischer Speicherelemente; Speicherelemente hierfür (G11C 14/00-G11C 21/00 haben Vorrang) [5]
G11C 11/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen Elementen
G11C 11/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit zylinderförmigen Speicherelementen, z.B. Stab, Draht (G11C 11/12 , G11C 11/14 haben Vorrang) [2]
G11C 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Speicherelementen mit einer einzigen Öffnung, z.B. Ringkern; mit Platten mit mehreren Öffnungen, wobei jede einzelne Öffnung ein Speicherelement bildet
G11C 11/061	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Speicherelementen mit einer einzigen Öffnung oder mit einem Magnetkreis, wobei ein Element pro Bit verwendet und wobei beim Auslesen gelöscht wird [2]
G11C 11/063	4-Punkt Untergruppe	. . . bit-organisiert, z.B. 2L/2D-, 3D-Organisation, d.h. organisiert zur Auswahl eines Elements mit wenigstens zwei koinzidenten Teilströmen sowohl zum Auslesen als auch zum Einschreiben [2]
G11C 11/065	4-Punkt Untergruppe	. . . wort-organisiert, z.B. mit 2D-Organisation oder lineare Auswahl, d.h. organisiert zur Auswahl aller Elemente eines Wortes mittels eines einzigen Vollstroms beim Auslesen [2]
G11C 11/067	3-Punkt Untergruppe	. . mit Speicherelementen mit einer einzigen Öffnung oder mit einem Magnetkreis, wobei ein Element pro Bit verwendet und wobei beim Auslesen nicht gelöscht wird [2]
G11C 11/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Speicherelementen mit mehreren Öffnungen, z.B. Transfluxoren; mit Platten, die verschiedene, jeweils mit mehreren Öffnungen versehene Speicherelemente bilden (G11C 11/10 hat Vorrang; Platten mit mehreren Öffnungen, wobei jede einzelne Öffnung ein Speicherelement bildet G11C 11/06) [2]
G11C 11/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit mehraxialen Speicherelementen
G11C 11/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit Tensoren; mit Twistoren, d.h. mit Elementen, in denen eine Achse der Magnetisierung gedreht ist
G11C 11/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit Dünnschichtelementen
G11C 11/15	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehreren magnetischen Schichten (G11C 11/155 hat Vorrang) [2]

Symbol	Typ	Titel
G11C 11/155	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zylindrischer Konfiguration [2]
G11C 11/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit Elementen, in denen der Speichereffekt auf dem magnetischen Spineffekt beruht
G11C 11/18	1-Punkt Untergruppe	. mit Halleffekt-Elementen
G11C 11/19	1-Punkt Untergruppe	. mit nichtlinearen Reaktanzen in Resonanzkreisen [2]
G11C 11/20	2-Punkt Untergruppe	. . mit Parametrons [2]
G11C 11/21	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen Elementen [2]
G11C 11/22	2-Punkt Untergruppe	. . mit ferroelektrischen Elementen [2]
G11C 11/23	2-Punkt Untergruppe	. . mit elektrostatischer Speicherung auf einer gemeinsamen Schicht, z.B. Forrester-Haeff-Röhren (G11C 11/22 hat Vorrang) [2]
G11C 11/24	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kondensatoren (G11C 11/22 hat Vorrang; in Kombination mit Halbleitern und Kondensatoren G11C 11/34 , z.B. G11C 11/40) [2, 5]
G11C 11/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit Entladungsröhren [2]
G11C 11/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit gasgefüllten Röhren [2]
G11C 11/30	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Hochvakuumröhren (G11C 11/23 hat Vorrang) [2]
G11C 11/34	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleitern [2]
G11C 11/35	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Ladungsspeicherung in einer Verarmungsschicht, z.B. ladungsgekoppelte Bauelemente [Charge Coupled Devices = CCD] [7]
G11C 11/36	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Dioden, z.B. als Schwellwertelemente [2]
G11C 11/38	4-Punkt Untergruppe mit Tunnelioden [2]
G11C 11/39	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Thyristoren [5]
G11C 11/40	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Transistoren [2]
G11C 11/401	4-Punkt Untergruppe bestehend aus Zellen, die eine Auffrischung oder Ladungsregeneration benötigen, d.h. dynamische Zellen [5]
G11C 11/402	5-Punkt Untergruppe mit Ladungsregeneration für jede einzelne Speicherzelle, d.h. interne Auffrischung [5]
G11C 11/403	5-Punkt Untergruppe mit gemeinsamer Ladungsregeneration für mehrere Speicherzellen, d.h. externe Auffrischung [5]
G11C 11/404	6-Punkt Untergruppe mit einer Ladungstransferstrecke pro Zelle, z.B. MOS-Transistor [5]
G11C 11/405	6-Punkt Untergruppe mit drei Ladungstransferstrecken pro Zelle, z.B. MOS- Transistoren [5]
G11C 11/406	5-Punkt Untergruppe Überwachung oder Regelung der Auffrisch- oder Ladungsregenerationszyklen [5]
G11C 11/4063	5-Punkt Untergruppe Hilfsschaltungen, z.B. zum Adressieren, Decodieren, Treiben, Schreiben, Abtasten oder zur Zeitsteuerung [7]
G11C 11/4067	6-Punkt Untergruppe für bipolare Speicherzellen [7]
G11C 11/407	6-Punkt Untergruppe Zusatzschaltungen für Feldeffektspeicherzellen [5]
G11C 11/4072	7-Punkt Untergruppe Schaltungen zum Initialisieren, zum Einschalten, zum Abschalten in den Ruhezustand, zum Löschen des Speichers oder zum Voreinstellen [7]

Symbol	Typ	Titel
G11C 11/4074	7-Punkt Untergruppe Schaltungen zur Stromversorgung oder zur Spannungserzeugung, z.B. Vorspannungserzeuger, Substratspannungserzeuger, Reservestromversorgung, Stromversorgungssteuerung [7]
G11C 11/4076	7-Punkt Untergruppe Zeitsteuerungen (zur Überwachung der Regeneration G11C 11/406) [7]
G11C 11/4078	7-Punkt Untergruppe Sicherheits- oder Schutzschaltungen, z.B. zum Verhindern des versehentlichen oder unberechtigten Lesens oder Schreibens; Zustandszellen; Prüfcellen (Schutz des Speicherinhalts während des Prüfens oder Testens G11C 29/52) [7]
G11C 11/408	7-Punkt Untergruppe Adressierschaltungen [5]
G11C 11/409	7-Punkt Untergruppe Lese-/Schreib[R/W]-Schaltungen [5]
G11C 11/4091	8-Punkt Untergruppe Abtast- oder Abtast/Refresh-Verstärker oder verwandte Abtastschaltungen, z.B. gekoppeltes Vorladen, Ausgleichen oder Isolieren der Bitleitungen [7]
G11C 11/4093	8-Punkt Untergruppe Anordnungen für Dateneingabe-/Datenausgabe[I/O]-Schnittstellen, z.B. Datenpuffer (Pegelumsetzer allgemein H03K 19/0175) [7]
G11C 11/4094	8-Punkt Untergruppe Schaltungen zur Verwaltung oder Steuerung der Bitleitungen [7]
G11C 11/4096	8-Punkt Untergruppe Schaltungen zur Verwaltung oder Steuerung der Dateneingabe/-ausgabe [I/O], z.B. Lese- oder Schreibschaltungen, I/O-Treiber, Bitleitungsschalter [7]
G11C 11/4097	8-Punkt Untergruppe Bitleitungsorganisation, z. B. bit-line layout, folded bit-lines [7]
G11C 11/4099	8-Punkt Untergruppe Behandlung von Leerzellen; Referenzspannungserzeuger [7]
G11C 11/41	4-Punkt Untergruppe bestehend aus Zellen mit positiver Rückkopplung, d.h. Zellen, die keine Auffrischung oder Ladungsregeneration benötigen, z.B. bistabiler Multivibrator oder Schmitt-Trigger [5]
G11C 11/411	5-Punkt Untergruppe nur mit Bipolartransistoren [5]
G11C 11/412	5-Punkt Untergruppe nur mit Feldeffekttransistoren [5]
G11C 11/413	5-Punkt Untergruppe Zusatzschaltungen, z.B. zum Adressieren, Decodieren, Treiben, Schreiben, Abtasten, zur Zeitsteuerung oder Leistungsreduzierung [5]
G11C 11/414	6-Punkt Untergruppe für bipolare Speicherzellen [5]
G11C 11/415	7-Punkt Untergruppe Adressierschaltungen [5]
G11C 11/416	7-Punkt Untergruppe Lese-/Schreib[R/W]-Schaltungen [5]
G11C 11/417	6-Punkt Untergruppe für Feldeffekt-Speicherzellen [5]
G11C 11/418	7-Punkt Untergruppe Adressierschaltungen [5]
G11C 11/419	7-Punkt Untergruppe Lese-/Schreib[R/W]-Schaltungen [5]
G11C 11/4193	3-Punkt Untergruppe	. . . für spezielle Halbleiterspeicherbauelemente typische Hilfsschaltungen, z.B. zum Adressieren, Treiben, Abtasten, zur Zeitsteuerung, Stromversorgung, Signalausbreitung (G11C 11/4063 , G11C 11/413 haben Vorrang) [7]
G11C 11/4195	4-Punkt Untergruppe Adressierschaltungen [7]
G11C 11/4197	4-Punkt Untergruppe Schreib-/Lese[R/W]-Schaltungen [7]
G11C 11/42	2-Punkt Untergruppe	. . mit optoelektrischen Bauelementen, d.h. elektrisch oder optisch gekoppelten lichtemittierenden und fotoelektrischen Bauelementen
G11C 11/44	2-Punkt Untergruppe	. . mit supraleitfähigen Elementen, z.B. Kryotron [2]
G11C 11/46	1-Punkt Untergruppe	. mit thermoplastischen Elementen

Symbol	Typ	Titel
G11C 11/48	1-Punkt Untergruppe	. mit verschiebbaren Koppellementen, z.B. mit ferromagnetischen Kernen, zum Kippen zwischen verschiedenen Zuständen einer induktiven Kopplung oder Selbstinduktion
G11C 11/50	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen Kontakten zur Speicherung von Informationen (mechanische Speicher G11C 23/00; Schalter, mit denen durch eine einzige manuelle Betätigung des Betätigungsteiles eine ausgewählte Anzahl von aufeinanderfolgenden Schaltvorgängen bewirkt wird H01H 41/00)
G11C 11/52	2-Punkt Untergruppe	. . mit elektromagnetischen Relais
G11C 11/54	1-Punkt Untergruppe	. mit Elementen zur Simulierung von biologischen Zellen, z.B. Neuronen
G11C 11/56	1-Punkt Untergruppe	. mit Speicherelementen mit mehr als zwei stabilen Zuständen, die durch Stufen, z.B. von Spannung, Strom, Phase, Frequenz repräsentiert sind (Zählansordnungen, die multistabile Elemente dieser Art aufweisen H03K 25/00 , H03K 29/00) [2]
G11C 13/00	Hauptgruppe	Digitale Speicher, gekennzeichnet durch die Verwendung von Speicherelementen, soweit sie nicht von den Gruppen G11C 11/00 , G11C 23/00 oder G11C 25/00 umfasst sind
G11C 13/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Elementen, deren Wirkungsweise auf chemischen Änderungen beruht (Verwendung elektrochemischer Ladung G11C 11/00)
G11C 13/04	1-Punkt Untergruppe	. mit optischen Elementen
G11C 13/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit magnetooptischen Elementen (Magnetooptik allgemein G02F) [2]
G11C 14/00	Hauptgruppe	Digitale Speicher, gekennzeichnet durch Speicherzellenanordnungen mit flüchtigem und nichtflüchtigem Speicherverhalten zum Informationserhalt bei ausgefallener Spannung [5]
G11C 15/00	Hauptgruppe	Digitale Speicher, in denen eine mit einem oder mehreren charakteristischen Teilen versehene Information eingeschrieben und dadurch ausgelesen wird, dass der oder die charakteristischen Teile aufgesucht werden, d.h. assoziative oder inhaltsadressierte Speicher (Speicher, in denen Informationen an einen bestimmten Speicherplatz gebunden sind G11C 11/00) [2]
G11C 15/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen Elementen [2]
G11C 15/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Halbleiterelementen [2]
G11C 15/06	1-Punkt Untergruppe	. mit supraleitfähigen Elementen, z.B. Kryotrons [2]
G11C 16/00	Hauptgruppe	Löschbare, programmierbare Festwertspeicher (G11C 14/00 hat Vorrang) [5]
G11C 16/02	1-Punkt Untergruppe	. elektrisch programmierbar [5]
G11C 16/04	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Transistoren mit variablem Schwellenwert, z.B. FAMOS [5]
G11C 16/06	2-Punkt Untergruppe	. . Hilfsschaltungen, z.B. für Schreiben in den Speicher (allgemein G11C 7/00) [5]
G11C 16/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Adressierschaltungen; Decoder; Steuerschaltungen für Wortleitungen [7]
G11C 16/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Programmier- oder Dateneingabeschaltungen [7]
G11C 16/12	4-Punkt Untergruppe Programmierspannungsschaltungen [7]
G11C 16/14	4-Punkt Untergruppe elektrische Löschsaltungen, z.B. Löschspannungsschaltungen [7]
G11C 16/16	5-Punkt Untergruppe zum Löschen von Blöcken, z.B. Arrays, Wörter, Gruppen [7]
G11C 16/18	4-Punkt Untergruppe Optische Löschsaltungen [7]
G11C 16/20	4-Punkt Untergruppe Initialisierung; Datenvoreinstellung; Chipidentifizierung [7]
G11C 16/22	3-Punkt Untergruppe	. . . Sicherheits- oder Schutzschaltungen zur Verhinderung des unerlaubten oder zufälligen Zugriffs auf Speicherzellen [7]
G11C 16/24	3-Punkt Untergruppe	. . . Bitleitungskontrollschaltungen [7]

Symbol	Typ	Titel
G11C 16/26	3-Punkt Untergruppe	. . . Abtast- oder Leseschaltungen; Datenausgabeschaltungen [7]
G11C 16/28	4-Punkt Untergruppe mit differenzieller Abtastung oder mit Referenzzellen, z.B. Leerzellen [7]
G11C 16/30	3-Punkt Untergruppe	. . . Spannungsversorgungsschaltungen [7]
G11C 16/32	3-Punkt Untergruppe	. . . Zeitgeberschaltungen [7]
G11C 16/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Ermitteln des Programmierzustands, z.B. Schwellenspannung, Über- oder Unterprogrammierung, Datenhaltung [7]
G11C 17/00	Hauptgruppe	Nur einmal programmierbare Festwertspeicher; Halbfestwertspeicher, z.B. mit manuell auswechselbaren Informationsträgerkarten (löschrare programmierbare Festwertspeicher G11C 16/00; Codieren, Decodieren oder Codeumsetzung allgemein H03M) [2, 5]
G11C 17/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen oder induktiven Elementen oder mit magnetischer oder induktiver Kopplung (G11C 17/14 hat Vorrang) [2, 5]
G11C 17/04	1-Punkt Untergruppe	. mit kapazitiven Elementen oder kapazitiver Kopplung (G11C 17/06 , G11C 17/14 haben Vorrang) [2, 5]
G11C 17/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Dioden oder mit Dioden-Kopplung (G11C 17/14 hat Vorrang) [2, 5]
G11C 17/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Halbleiterbauelementen, z.B. bipolaren Bauelementen (G11C 17/06 , G11C 17/14 haben Vorrang) [5]
G11C 17/10	2-Punkt Untergruppe	. . in denen der Speicherinhalt während des Herstellungsvorgangs durch eine vorher festgelegte Anordnung von Koppellementen bestimmt wird, z.B. maskenprogrammierbarer Festwertspeicher [ROM] [5]
G11C 17/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Feldeffekt-Bauelementen [5]
G11C 17/14	1-Punkt Untergruppe	. in denen der Speicherinhalt durch selektives Herstellen, Unterbrechen oder Ändern von Verbindungsstellen durch bleibende Änderung des Zustands von Koppellementen bestimmt wird, z.B. PROM [5]
G11C 17/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit Koppellementen, die die Funktion einer elektrischen Sicherung aufweisen [5]
G11C 17/18	2-Punkt Untergruppe	. . Hilfsschaltungen, z.B. für Schreiben in den Speicher (allgemein G11C 7/00) [5]
G11C 19/00	Hauptgruppe	Digitale Speicher, in denen die Information schrittweise bewegt wird, z.B. Schieberegister (Zählketten H03K 23/00)
G11C 19/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen Elementen (G11C 19/14 hat Vorrang) [2]
G11C 19/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kernen mit einer Öffnung oder einem Magnetkreis [2]
G11C 19/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit mehreren Öffnungen oder Magnetkreisen, z.B. Transfluxoren [2]
G11C 19/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit dünnen Filmen in ebener Anordnung [2]
G11C 19/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit dünnen Filmen auf Stäben; mit Twistoren [2]
G11C 19/12	1-Punkt Untergruppe	. mit nichtlinearen Reaktanzen in Resonanzkreisen [2]
G11C 19/14	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetischen Elementen in Kombination mit aktiven Elementen, z.B. mit Entladungsröhren, mit Halbleiterbauelementen (G11C 19/34 hat Vorrang) [2, 7]
G11C 19/18	1-Punkt Untergruppe	. mit Kondensatoren als Hauptelemente der Stufen [2]
G11C 19/20	1-Punkt Untergruppe	. mit Entladungsröhren (G11C 19/14 hat Vorrang) [2]
G11C 19/28	1-Punkt Untergruppe	. mit Halbleiterbauelementen (G11C 19/14 , G11C 19/36 haben Vorrang) [2, 7]
G11C 19/30	1-Punkt Untergruppe	. mit optoelektronischen Anordnungen, d.h. lichtemittierenden und fotoelektrischen Anordnungen, die elektrisch oder optisch gekoppelt sind [2]
G11C 19/32	1-Punkt Untergruppe	. mit supraleitenden Elementen [2]

Symbol	Typ	Titel
G11C 19/34	1-Punkt Untergruppe	. mit Speicherelementen, die mehr als zwei stabile, durch Stufen verkörperte Zustände aufweisen, z.B. Spannung, Strom, Phase, Frequenz [7]
G11C 19/36	2-Punkt Untergruppe	. . mit Halbleiterbauelementen [7]
G11C 19/38	1-Punkt Untergruppe	. zweidimensional, z.B. horizontale und vertikale Schieberegister [7]
G11C 21/00	Hauptgruppe	Digitale Speicher, in denen die Information zirkuliert (schrittweise G11C 19/00)
G11C 21/02	1-Punkt Untergruppe	. mit elektromechanischen Verzögerungsleitungen, z.B. mit Quecksilber-Behälter
G11C 23/00	Hauptgruppe	Digitale Speicher, gekennzeichnet durch die Bewegung mechanischer Teile zur Herstellung eines Speichereffektes, z.B. Kugeln; Speicherelemente hierfür (Speicherung durch Betätigen von Kontakten G11C 11/48)
G11C 25/00	Hauptgruppe	Digitale Speicher, gekennzeichnet durch die Verwendung fließfähiger Medien; Speicherelemente hierfür
G11C 27/00	Hauptgruppe	Elektrische Analogspeicher, z.B. zur Speicherung von Augenblickswerten
G11C 27/02	1-Punkt Untergruppe	. Abtast- und Speicheranordnungen (G11C 27/04 hat Vorrang; Abtasten elektrischer Signale allgemein H03K) [2, 4]
G11C 27/04	1-Punkt Untergruppe	. Schieberegister (ladungsggekoppelte Bauelemente <u>an sich</u> H01L 29/76) [4]
G11C 29/00	Hauptgruppe	Prüfen von Speichern auf richtige Arbeitsweise; Testen von Speichern während des Standby- oder Offline-Betriebs [1, 2006.01]
G11C 29/02	1-Punkt Untergruppe	. Ermitteln oder Lokalisieren defekter Hilfsschaltungen, z.B. defekter Refresh- Zähler [2006.01]
G11C 29/04	1-Punkt Untergruppe	. Ermitteln oder Lokalisieren defekter Speicherelemente [2006.01]
G11C 29/06	2-Punkt Untergruppe	. . zeitraffende Prüfung [2006.01]
G11C 29/08	2-Punkt Untergruppe	. . Funktionsprüfung, z.B. Prüfung während einer Auffrischung, Einschalt-Selbsttest [power- on self testing (POST)] oder verteilter Prüfung [2006.01]
G11C 29/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Prüfalgorithmen, z.B. Speicher- Scan- Algorithmen (MScan); Prüfmuster, z.B. Schachbrettmuster [2006.01]
G11C 29/12	3-Punkt Untergruppe	. . . eingebaute Prüfanordnungen, z.B. eingebauter Selbsttest (BIST) [2006.01]
G11C 29/14	4-Punkt Untergruppe Implementierung von Steuerlogik, z.B. Testmodusdecoder [2006.01]
G11C 29/16	5-Punkt Untergruppe unter Verwendung mikroprogrammierter Einheiten, z.B. Zustandsmaschinen [2006.01]
G11C 29/18	4-Punkt Untergruppe Adressengeneratoren; Einrichtungen für Speicherzugriff, z.B. Einzelheiten von Adressierschaltungen [2006.01]
G11C 29/20	5-Punkt Untergruppe unter Verwendung von Zählern oder Schieberegistern mit linearer Rückkopplung (LFSR) [2006.01]
G11C 29/22	5-Punkt Untergruppe Zugriff auf serielle Speicher [2006.01]
G11C 29/24	5-Punkt Untergruppe Zugriff auf Zusatzzellen, z.B. Dummy-Zellen oder redundante Zellen [2006.01]
G11C 29/26	5-Punkt Untergruppe Zugriff auf Mehrfach-Arrays (G11C 29/24 hat Vorrang) [2006.01]
G11C 29/28	6-Punkt Untergruppe Abhängige Mehrfach-Arrays, z.B. Multibit-Arrays [2006.01]
G11C 29/30	5-Punkt Untergruppe Zugriff auf Einfach-Arrays [2006.01]
G11C 29/32	6-Punkt Untergruppe serieller Zugriff; Scan- Test [2006.01]
G11C 29/34	6-Punkt Untergruppe simultaner Zugriff auf mehrere Bits [2006.01]
G11C 29/36	4-Punkt Untergruppe Bauelemente zur Datenerzeugung, z.B. Dateninverter [2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G11C 29/38	4-Punkt Untergruppe Bauelemente zur Überprüfung der Antwort [2006.01]
G11C 29/40	5-Punkt Untergruppe Unter Verwendung von Kompressionstechniken [2006.01]
G11C 29/42	5-Punkt Untergruppe Unter Verwendung von Fehlerkorrekturcodes (ECC) oder Paritätsprüfung [2006.01]
G11C 29/44	4-Punkt Untergruppe Anzeige oder Feststellung von Fehlern, z.B. zur Reparatur [2006.01]
G11C 29/46	4-Punkt Untergruppe Testauslöselogik [2006.01]
G11C 29/48	3-Punkt Untergruppe	. . . Anordnungen in statischen Speichern speziell angepasst an die Prüfung mit Mitteln außerhalb des Speichers, z.B. unter Verwendung von direktem Speicherzugriff (DMA) oder unter Verwendung externer Zugriffspfade (externe Prüfsysteme G11C 29/56) [2006.01]
G11C 29/50	2-Punkt Untergruppe	. . Grenzwertprüfung, z.B. Race, Spannungs- oder Stromprüfung [2006.01]
G11C 29/52	1-Punkt Untergruppe	. Schutz von Speicherinhalten; Fehlererkennung in Speicherinhalten [2006.01]
G11C 29/54	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Entwurf von Testschaltungen, z.B. design for test (DFT) tools [2006.01]
G11C 29/56	1-Punkt Untergruppe	. externe Prüfsysteme für statische Speicher, z.B. automatische Testsysteme (ATE); Schnittstellen hierfür [2006.01]
G11C 99/00	Hauptgruppe	Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]